

Содержание

Предисловие редактора	5
1. Теория образования зародышей при осаждении на подложках. <i>Хирс Дж. П., Хруска С. Дж., Паунд Г. М.</i>	15
2. Образование зародышей в ориентированных пленках. <i>Родин Т. Н., Уолтон Д.</i>	44
3. Рост ориентированных пленок на аморфных поверхностях. <i>Бауэр Е.</i>	58
4. Рентгеновское исследование структуры медных пленок, полученных испарением в высоком вакууме. <i>Вук Р. В., Шёнинг Ф. Р. Л., Витт Ф.</i>	91
5. Ориентированный рост тонких пленок теллурида серебра. <i>Панародитис К.</i>	104
6. Эффекты ориентации в пленках соединений и сплавов, полученных методом катодного распыления. <i>Франкомб М. Х., Хан И. Х., Флуд Дж. Дж., Шлактер М. М.</i>	118
7. Параметры катодного распыления, определяющие эпитаксиальный рост полупроводниковых монокристаллических пленок. <i>Крикорян Е.</i>	145
8. Изучение роста кристаллов в германиевых пленках. <i>Полер Т. О., Гильберт Дж. Б.</i>	164
9. Несовпадение кристаллических решеток и силы связи на поверхности раздела между ориентированными пленками и подложками. <i>Ван-дер-Мерве Дж. Х.</i>	172
10. Наблюдение дислокаций несоответствия в сплавах золото — палладий с небольшим различием состава. <i>Мэтьюз Дж. В.</i>	202
11. Движение дислокаций поверхности раздела в процессе диффузии. <i>Хирс Дж. П.</i>	211

12. Теория азимутального расположения при эпитаксии. <i>Беттман М.</i>	215
13. Электронно-оптическое исследование эпитаксиального роста. <i>Хонд-жо Г.</i>	229
14. Новые исследования роста и структуры тонких пленок. <i>Селла К., Трийа Ж. Ж.</i>	242
15. Наблюдение дислокаций поверхности раздела при эпитаксиальном росте бромида никеля на тонких кристаллах бромида хрома. <i>Грюнбаум Е., Митчелл Дж. В.</i>	262
16. Эпитаксиальное осаждение методом дискретного испарения. <i>Ричардс Дж. Л., Гарт П. Б., Мюллер Е. К.</i>	273
17. Рост и дефекты в эпитаксиальных пленках кремния, осаждаемых на подложки с различной ориентацией. <i>Мендельсон С.</i>	282
18. Рост монокристаллических слоев арсенида галлия на германиевых подложках. <i>Амик Дж. А.</i>	320
19. Влияние температуры и конфигурации подложки на эпитаксиальный рост германиевых пленок. <i>Шалла Р. Л., Тайдесвелл Н. В., Коффин Ф. Д.</i>	341
20. Нестандартный пример эпитаксиального роста. <i>Йелон А., Фёгели О.</i>	357
21. Применение метода эпитаксиальных пленок для изучения электронной структуры некоторых сплавов. <i>Сато Х.</i>	371
Указатель авторов	392
Предметный указатель	394

МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ ПЛЕНКИ

Редактор *В. С. Хангулова*, Художник *А. Шкловская*

Художественный редактор *Н. А. Фильчагина*, Технический редактор *М. П. Грибова*

Корректор *В. И. Киселева*

Сдано в производство 14/V 1966 г. Подписано к печати 5/IX 1966 г.

Бумага 60×90¹/₁₆=12,5 бум. л. 25 усл. печ. л. Уч-изд. л. 23,23. Изд. № 20/3437

Цена 1 р. 88 к. Зак. 268

(Темплан 1966 г. изд-ва «МИР», пор. № 218)

ИЗДАТЕЛЬСТВО «МИР»

Москва, 1-й Рижский пер., 2

Московская типография № 16 Главполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров СССР. Москва, Трехпрудный пер., 9